



(19) 대한민국특허청(KR)
 (12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2014년09월18일
 (11) 등록번호 10-1442097
 (24) 등록일자 2014년09월12일

- (51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G11B 5/33 (2006.01)
- (21) 출원번호 10-2013-0048696
 (22) 출원일자 2013년04월30일
 심사청구일자 2013년04월30일
 (65) 공개번호 10-2013-0122588
 (43) 공개일자 2013년11월07일
 (30) 우선권주장
 13/460,058 2012년04월30일 미국(US)
 (56) 선행기술조사문현
 US20070035893 A1*
 JP2007287239 A*
 *는 심사관에 의하여 인용된 문현

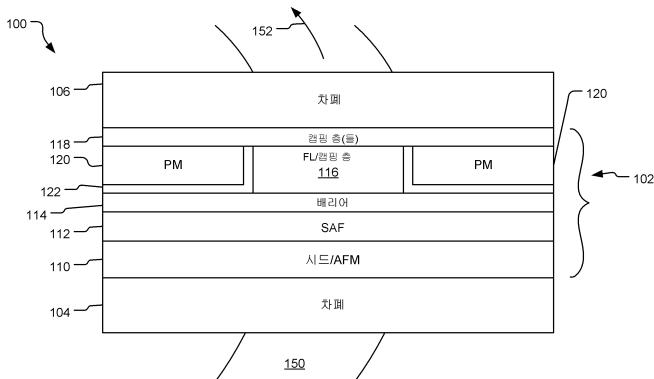
(73) 특허권자
시게이트 테크놀로지 엘엘씨
 미국 캘리포니아 95104 쿠퍼티노 사우쓰 디 엔자
 블러바드 10200
 (72) 발명자
싱글톤, 에릭, 월터
 미국 55359 미네소타 메이플 플레이 마쉬 포인트
 더블유 3780
이, 재-영
 미국 55372 미네소타 프라이어 레이크 쿠거 패스
 엔더블유 2731
 (뒷면에 계속)
 (74) 대리인
특허법인 남앤드남

전체 청구항 수 : 총 17 항

심사관 : 권영학

(54) 발명의 명칭 **넓은 시드충을 갖는 스택****(57) 요약**

스택은 제 1 크로스-트랙 폭을 갖는 제 1 부분을 구비한 시드충 구조 및 시드충 구조 위에 증착되고 제 2 크로스-트랙 폭을 구비한 자유충을 가지며, 제 1 크로스-트랙 폭은 제 2 크로스-트랙 폭보다 크다. 일 구현에서, 시드충 구조는 반강자성(AFM)충 및 합성 반강자성(SAF)충을 더 포함한다. 일 대안적인 구현에서, 시드충 구조의 크로스-트랙 폭은 2개의 영구 자석들의 크로스 트랙 폭 및 자유충의 결합된 크로스-트랙 폭과 실질적으로 동일하다.

대 표 도 - 도1

(72) 발명자

니콜라에프, 콘스탄틴

미국 55438 미네소타 블루밍턴 브리스톨 빌리지 드
라이브 7350 #230

사포츠니코브, 빅터, 보리스

미국 55345 미네소타 미네통카 마운트 테라스
14009

웨이크햄, 스테이시, 크리스틴

미국 55438 미네소타 블루밍턴 페실베니아 로드
8225

맥킨레이, 사운, 에릭

미국 55346 미네소타 이든 프레리 홀리 로드 13905

특허청구의 범위

청구항 1

스택으로서,

제 1 크로스-트랙 폭을 갖는 제 1 부분을 구비한 시드층 구조; 및

상기 시드층 구조 위에 중첩되고 그리고 제 2 크로스-트랙 폭을 갖는 자유층을 포함하며,

상기 제 1 크로스-트랙 폭은 상기 제 2 크로스-트랙 폭 보다 더 크고, 상기 시드층 구조의 높이는 상기 제 1 크로스-트랙 폭보다 더 큼,

스택.

청구항 2

삭제

청구항 3

제 1 항에 있어서,

상기 자유층은 2개의 영구 자석들 사이에 위치되고 그리고

상기 제 1 크로스-트랙 폭은 상기 제 2 크로스-트랙 폭 및 상기 2개의 영구 자석들의 결합된 크로스 트랙 폭과
실질적으로 동일한,

스택.

청구항 4

제 1 항에 있어서,

상기 자유층이 사이에 개재되어 있는 2개의 영구 자석들을 더 포함하고,

상기 시드층 구조는 반강자성(AFM; antiferromagnetic)층을 포함하고,

상기 AFM 층 및 상기 자유층은 중첩되지 않는,

스택.

청구항 5

제 1 항에 있어서,

상기 시드층 구조의 상기 제 1 부분은 합성형 반강자성(SAF; synthetic antiferromagnetic)층인,

스택.

청구항 6

제 1 항에 있어서,

상기 시드층 구조는 테이퍼드(tapered) 크로스-트랙 폭을 갖는 반강자성(AFM)층을 더 포함하는,

스택.

청구항 7

제 1 항에 있어서,

상기 시드층 구조는 사다리꼴 형상을 갖는 반강자성(AFM)층을 더 포함하는,

스택.

청구항 8

제 1 항에 있어서,
2개의 차폐들을 더 포함하고,

상기 시드층 구조 및 상기 자유층은 상기 2개의 차폐들 간의 차폐-대-차폐 간격(shield-to-shield spacing)을
감소시킴으로써 상기 스택의 비대칭(asymmetry)을 4%로 또는 4% 미만으로 감소시키는,
스택.

청구항 9

삭제

청구항 10

스택으로서,
제 1 영구 자석과 제 2 영구 자석 사이에 있는 자유층;

반강자성(AFM)층 구조 – 상기 AFM 층 구조의 적어도 일 부분의 크로스-트랙 폭은 상기 자유층의 크로스-트랙 폭
보다 더 크고, 상기 AFM 층 구조의 높이는 상기 AFM 층 구조의 상기 크로스-트랙 폭보다 더 큼 –, 및
상기 자유층과 영구 자석들의 결합과 상기 AFM 층 구조 사이에 위치되는 터널링 배리어층을 포함하는,
스택.

청구항 11

제 10 항에 있어서,
상기 AFM 층 구조의 크로스-트랙 폭은 상기 영구 자석들 및 상기 자유층의 결합된 크로스-트랙 폭과 실질적으로
동일한,
스택.

청구항 12

제 10 항에 있어서,
상기 AFM 층 구조는,
상기 터널링 배리어층에 인접한 합성형 반강자성(SAF)층; 및
AFM 물질을 포함하는 시드층을 더 포함하는,
스택.

청구항 13

제 12 항에 있어서,
상기 SAF 층의 적어도 일부가 차폐층에 인접하는,
스택.

청구항 14

제 13 항에 있어서,
상기 차폐층에 인접하는 상기 SAF 층의 부분의 크로스-트랙 폭은 상기 자유층의 상기 크로스-트랙 폭과 실질적
으로 동일한,
스택.

청구항 15

제 12 항에 있어서,

상기 AFM 층 구조의 크로스-트랙 표면은 상기 자유층의 크로스-트랙 표면과 중첩되지 않는,
스택.

청구항 16

삭제

청구항 17

제 10 항에 있어서,

상기 AFM 층 구조의 높이는 상기 자유층의 상기 크로스-트랙 폭보다 더 큰,
스택.

청구항 18

디바이스로서,

자유층;

합성형 반강자성(SAF)층; 및

반강자성(AFM)층 구조를 포함하며,

상기 AFM 층 구조의 적어도 일 부분의 크로스-트랙 폭은 상기 자유층의 크로스-트랙 폭보다 더 크고, 상기 AFM 층 구조의 높이는 상기 AFM 층 구조의 상기 크로스-트랙 폭보다 더 큰,

디바이스.

청구항 19

제 18 항에 있어서,

상기 AFM 층 구조는 차폐층 상에 위치되며 상기 차폐층의 적어도 일 부분이 크로스-트랙 방향을 따라 상기 AFM 층 구조의 부분들 사이에 위치되는,

디바이스.

청구항 20

제 18 항에 있어서,

상기 자유층은 크로스-트랙 방향을 따라 제 1 영구 자석과 제 2 영구 자석 사이에 위치되는,

디바이스.

명세서

기술분야

[0001]

자기 데이터 저장 및 리트리벌 시스템에서, 자기 판독/기록 헤드는 자기 디스크에 저장된 자기적으로 인코딩된 정보를 리트리브하기 위해 자기저항(MR) 센서를 갖는 판독기 부분을 포함한다. 디스크의 표면으로부터의 자속은 MR 센서의 감지층의 자화 벡터의 회전을 일으키고, 이는 결국 MR 센서의 전기 저항에서 변화를 일으킨다. MR 센서의 저항의 변화는, 전류를 MR 센서에 통과시키고 MR 센서 양단의 전압을 측정함으로써 검출될 수 있다. 그런 다음, 외부 회로소자(circuitry)가, 전압 정보를 적절한 포맷으로 전환하고, 디스크에 인코딩되어 있는 정보를 복원하기 위해 그 정보를 조작(manipulate)한다.

발명의 내용

과제의 해결 수단

[0002]

본원에 설명되고 청구되는 구현들은 스택을 제공하며, 이 스택은 제 1 크로스-트랙(cross-track) 폭을 갖는 제 1 부분을 구비한 시드(seed)층 구조 및 시드층 구조 위에 증착되고 그리고 제 2 크로스-트랙 폭을 갖는 자유층을 가지며, 제 1 크로스-트랙 폭은 제 2 크로스-트랙 폭 보다 더 크다. 일 대안적인 구현에서, 시드층 구조의 크로스-트랙 폭은 2개의 영구 자석들의 크로스-트랙 폭 및 자유층의 결합된 크로스-트랙 폭과 실질적으로 동일하다.

[0003]

본 발명의 하나 또는 그 초과의 실시형태들의 상세들은 아래에 첨부된 도면들 및 설명에 제시된다. 이러한 특징들 및 용도들 그리고 다양한 다른 특징들 및 용도들은 다음 상세한 설명을 읽음으로써 명백해질 것이다.

도면의 간단한 설명

[0004]

도 1은 자기저항 센서를 포함하는 예시적 판독 헤드를 도시하는 개략적인 블록도를 도시한다.

도 2는 자기저항 센서를 포함하는 예시적인 판독 헤드를 도시하는 대안적인 개략적 블록도를 도시한다.

도 3 내지 도 5는 자기저항 센서를 포함하는 예시적 판독 헤드를 제조하는 다양한 스테이지들을 도시한다.

도 6은 자기저항 센서를 포함하는 예시적 판독 헤드를 도시하는 대안적인 개략적 블록도를 도시한다.

도 7은 자기저항 센서를 포함하는 예시적 판독 헤드를 도시하는 대안적인 개략적 블록도를 도시한다.

도 8은 자기저항 센서를 포함하는 예시적 판독 헤드를 도시하는 대안적인 개략적 블록도를 도시한다.

도 9는 자기저항 센서를 포함하는 예시적 판독 헤드를 도시하는 대안적인 개략적 블록도를 도시한다.

도 10은 자기저항 센서를 포함하는 예시적 판독 헤드를 도시하는 대안적인 개략적 블록도를 도시한다.

도 11은 자기저항 센서를 포함하는 판독 헤드를 제조하는 것을 도시하는 예시적 동작들을 도시한다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0005]

자기 매체로부터 데이터를 판독하기 위하여 높은 데이터 밀도들 및 감지 센서(sensitive sensor)들에 대한 수요가 증가하고 있다. 증가된 감도(sensitivity)를 갖는 거대 자기저항(GMR) 센서들은 구리 같은 얇은 전도성의, 비자성 스페이서층에 의해 분리되는 두 개의 연질(soft) 자기층들로 이루어진다. 터널 자기저항(TMR) 센서들은 전자들이 이동하는 GMR에 대한 범위를 제공하고 이때 상기 전자들의 스팬들은 얇은 절연 터널 배리어를 가로지르는 층들에 수직으로 배향된다(oriented). 반강자성(AFM) 물질(소위 "피닝 층(pinning layer)(PL)"이라고 함)은 제 1 연질 자기층이 회전하는 것을 방지하기 위하여 상기 제 1 연질 자기층에 인접하여 배치된다. 이런 특성을 나타내는 AFM 물질들은 "피닝 물질들"이라 칭해진다. 상기 제 1 연질 자기층의 회전이 방지되므로, 제 1 연질층은 "핀드층"이라 칭해진다. 제 2 연질층은 외부 장애에 응답하여 자유롭게 회전하고 "자유층(FL)"이라 불린다.

[0006]

MR 센서를 적절히 동작시키기 위해서는, 도메인 벽 모션이 데이터 복원을 어렵게 만드는 전기 잡음을 야기하기 때문에, 센서가 에지 도메인들의 형성에 대해 안정화되어야 한다. 안정화를 달성하는 일반적인 방법은 영구 자석 인접 접합 설계를 이용하는 것이다. 이 방식에서는, 높은 항전계를 갖는 영구 자석들(즉, 경질 자석들)이 센서의 각 단부에 배치된다. 영구 자석들로부터의 자기장은 센서를 안정화시키며, 에지 도메인 형성을 방지할 뿐만 아니라 적절한 바이어스를 제공한다. PL의 강성을 증가시키기 위해, SAF(synthetic antiferromagnet)가 PL에서 사용된다. AFM/PL의 사용은 SAF 구조의 일관적이고 예측가능한 배향을 허용한다. 더욱이, AFM/PL의 사용은 또한 MR 센서를 사용하는 판독기에 대한 높은 진폭 선형 응답을 가능하게 하기 위해 안정적인 구조를 제공한다.

[0007]

그러나, AFM/PL 구조를 사용하는 것은 판독기의 차폐-대-차폐 간격(SSS; shield-to-shield spacing)을 증가시킨다. 레코딩 시스템에서 SNR(signal-to-noise ratio)을 결정하는 자기 센서들의 펄스 폭 변동률 PW50이 헤더의 SSS에 의존하기 때문에, 더 낮은 SSS를 달성하는 것이 레코딩 시스템의 SNR을 감소시킨다. PW50과 SSS 간의 관계의 예는, 모델링 및 실험 둘 모두에 의해 제안될 때, 아래와 같이 제공될 수 있다:

$$\Delta \text{PW50} \cong 0.3 * \Delta \text{SSS}$$

[0009]

따라서, SSS의 감소는 PW50의 값의 감소로 이어지고, 그로 인해 레코딩 시스템에 대한 SNR 값이 증가한다. 따

라서, 판독기의 더 높은 선형 밀도는 SSS를 감소시킴으로써 달성될 수 있다. 더욱이, 더 작은 SSS는 또한 미디어 판독기의 크로스-트랙 분해능을 향상시키고, 크로스-트랙 분해능의 그러한 감소는 미디어 판독기에 의해 달성될 수 있는 면적 밀도의 추가적인 향상에 기여한다.

[0010] 여기서 개시된 센서 스택 어셈블리는 판독기에 대한 감소된 SSS를 제공한다. 특히, 센서 스택은 자유층 FL에 대해 넓은 면적의 범위를 갖는 SAF/AFM 구조를 포함한다. 감소된 SSS는 필스 폭 감소로 이어지고, 그로 인해서 그러한 AFM/PL 구조를 사용하는 판독기의 선형 밀도 성능의 증가로 이어진다. 더욱이, SSS를 감소시키는 것은 또한 판독기의 크로스-트랙 분해능을 향상시키고, 따라서 판독기의 면적 밀도 성능을 향상시킨다.

[0011] 더욱이, AFM/PL 시스템의 자기 분산은 또한, 다양한 판독기들에서 우세한 자기 잡음에 기여한다. AFM의 제거는 PL 자성체들이 연성의 단축(uniaxial) 특성들에 대해 최적이게 하여 잡음 감소로 이어진다. 반면에, AFM/PL 시스템은 SAF 구조의 일관되고 예측가능한 배향을 허용한다. 본 명세서에 개시된 센서 스택 어셈블리는 자유층 (FL)에 대해 넓은 면적의 범위를 갖는 SAF/AFM 구조를 제공한다. 센서 적층 어셈블리의 일 구현에서, SAF/AFM 폭은 인접한 영구 자석(PM)과 일치한다.

[0012] 본 명세서에 개시된 센서 적층 어셈블리의 대안적인 구현은 SAF/AFM 구조를 포함하며, 여기서 SAF/AFM 스트립의 높이는 SAF/AFM 스트립의 폭보다 더 길다(따라서 고 종횡비를 가짐). 다른 대안적인 구현에서, AFM이 FL을 포함하는 센서의 영역들에 바로 인접한 영역들로부터 제거되지만, AFM은 (FL로부터 떨어진 영역들인) FL의 영역들 폭에 존재한다. 이러한 구현은 안정적인 SAF 구조 및 SSS에서의 감소를 제공하여 PW50 개선을 발생시킨다. 또 다른 대안적인 구현에서, FL 및 SAF는 배리어층을 이용하여 서로로부터 디커플링된다.

[0013] 다른 대안적인 구현에서, AFM의 높이는 FL의 폭보다 더 크다(AFM의 높이는 AFM의 폭보다 더 작을 수 있음). 예를 들어, 이러한 구현에서, AFM은 FL 바로 아래의 영역으로부터 제거된다. 이러한 구현은, AFM 섹션의 높이가, 결합된 두 개의 AFM 섹션들의 전체 폭보다 더 작은 경우에도 AFM의 높이가 여러 가지의 개별 AFM 섹션들에 대한 AFM의 폭보다 더 크기 때문에 유리한 AFM 형상 이방성을 제공한다.

[0014] 도 1은 자기저항 센서(102)를 포함하는 예시적인 판독 헤드(100)를 도시하는 개략적인 블록도를 도시한다. 센서(100)의 구현은 디스크 드라이브에서 자기 판독/기록 헤드에 사용될 수 있다. 판독 헤드(100)는 디스크 드라이브의 데이터 디스크들로부터 데이터를 판독하기 위해 자기저항을 사용한다. 판독 헤드(100)의 정확한 특성은 광범위하게 변화할 수 있지만, 터널링 자기 저항(MR) 판독 헤드(100)가 본 명세서에 설명된 시드층들 및 SAF에 사용될 수 있는 판독 헤드(100)의 일례로서 설명된다. 그러나 SAF 및 시드층들은 예를 들어, 수직 전류 인가형 (CCP; current perpendicular-to-the-plane) 거대 자기 저항 헤드, 거대 자기 저항 헤드 또는 이와 유사한 것과 같은 임의의 유용한 판독 헤드(100)에 사용될 수 있다.

[0015] 일 구현에서, 판독 헤드(100)는 데이터 디스크들의 회전에 의해 생성되는 에어 베어링(air bearing) 상의 디스크 드라이브 데이터 디스크들의 표면 상을 비행(fly)한다. 데이터 디스크들은 다수의 데이터 트랙들(150)을 가지며, 이러한 데이터 트랙들 중 하나가 도 1에 도시되어 있다. 트랙들(150)은 복수의 비트들로 분할된다. 디스크가 화살표(152) 방향으로 회전할 때, 판독 헤드(100)는 데이터 트랙(150)을 따르고, 자기저항 센서(102) 아래를 통과할 때에 하나 또는 그 초과의 비트들을 판독한다.

[0016] 판독 헤드(100)는 제 1 차폐층(shield layer)(104) 및 제 2 차폐층(106)을 포함한다. 자기저항 센서(102)가 제 1 차폐층(104)과 제 2 차폐층(106) 사이에 위치된다. 높은 자기 투자율(magnetic permeability)을 갖는 물질로 이루어진 제 1, 2 차폐층들(104, 106)은, 외부로부터의(extraneous) 자기장들, 이를 테면, 예를 들어 데이터 디스크들 상의 인접하는 비트들로부터의 자기장들이 자기저항 센서(102)에 영향을 주는 것을 줄이거나 또는 실질적으로 차단으며, 이에 따라 자기저항 센서(102)의 성능을 개선한다. 일 구현에서, 제 1, 2 차폐층들(104, 106)은 자기저항 센서(102) 바로 아래의 비트로부터의 자기장들이 자기저항 센서(102)에 영향을 미칠 수 있게 하고, 그에 따라 판독될 수 있게 한다. 따라서, 비트들의 물리적인 크기가 계속해서 감소함에 따라, 차폐물간 간격(shield-to-shield spacing) 역시 감소되어야 한다.

[0017] 자기저항 센서(102)는, 반강자성(antiferromagnetic, AFM) 시드층(110), 합성형 반강자성(synthetic antiferromagnetic, SAF)층(112), 터널링 장벽층(114), 자유층(free layer)(116) 및 캡핑층(118)을 포함한 복수의 층들을 포함한다. 일 구현예에서, AFM 층(110)은 제 1 전극에 전기적으로 결합되고, 캡핑층(118)은 제 2 전극에 전기적으로 결합된다. 자기저항 센서(102)의 일 구현에서, 자유층(116)은 또한, 한 쌍의 영구 자석들(120) 사이에 위치되는 제 2 캡층을 포함한다.

[0018] 일 구현에서, SAF층(112)은 핀드층 및 기준층을 포함한다. 핀드층과 기준층의 각각의 자기 모멘트들은 관심 범

위 내의 자기장들(예를 들어, 데이터 디스크들 상에 저장된 데이터의 비트들에 의해 발생되는 자기장들) 하에서 회전하는 것이 허용되지 않는다. 기준층과 핀드층의 자기 모멘트들은 일반적으로 도 1의 평면에 수직으로 그리고 서로에 대해 역평행(anti-parallel)하게 배향된다.

[0019] 일 구현에서, 자유층(116)은 반강자성체(antiferromagnet)에 교환 결합(exchange coupled)되지 않는다. 결과적으로, 자유층(116)의 자기 모멘트는 관십 범위 내의 인가된 자기장의 영향 하에서 자유롭게 회전한다. 판독 헤드(100)는 영구 자석들(PM)(120)의 쌍을 더 포함하는 바, 이러한 영구 자석들의 쌍은, 도면의 평면에 평행하고 일반적으로 수평으로 배향되는 자기 모멘트로 자유층(116)을 바이어싱하는 자기장을 생성한다. 이러한 바이어스는, 판독 헤드(100)에 의해 감지되는 데이터 내에 노이즈를 도입시킬 수 있는, 예를 들어 열 에너지로 인해, 자유층(116)의 자기 모멘트가 드리프트하는 것을 막는다. 하지만, 이러한 바이어스는 충분히 작아서, 자유층(116)의 자기 모멘트는, 데이터 디스크들 상에 저장된 데이터 비트의 자기장과 같은 인가된 자기장에 응답하여 변할 수 있다. 자기저항 센서(102)는 절연 물질들을 포함하는 아이솔레이션층(122)에 의해 영구 자석들(120)로부터 분리되고 전기적으로 아이솔레이트된다.

[0020] 터널링 배리어층(114)이 SAF(112)와 자유층(116)을 분리한다. 터널링 배리어층(114)은 SAF(112)의 기준층과 자유층(116) 사이에서 양자역학적 전자 터널링이 일어나기에 충분히 얇다. 전자 터널링은 전자 스핀에 의존적이어서, 자기저항 센서(102)의 자기 응답이 SAF(112)와 자유층(116)의 상대적 배향들 및 스핀 분극들의 함수로 되게 한다. SAF(112)와 자유층(116)의 자성 모멘트들이 평행일 때 가장 높은 확률의 전자 터널링이 발생하고, SAF(112)와 자유층(116)의 자성 모멘트들이 역-평행일 때 가장 낮은 확률의 전자 터널링이 발생한다. 이에 따라, 자기 저항 센서(102)의 전기 저항은 인가되는 자기장에 응답하여 변한다. 디스크 드라이브의 데이터 디스크들 상의 데이터 비트들은 도면의 평면 안으로든 아니면 도면의 평면 바깥으로든, 도 1의 평면에 수직인 방향으로 자화된다. 따라서, 자기저항 센서(102)가 데이터 비트 위를 통과할 때, 자유층(116)의 자기 모멘트는 도 1의 평면 안으로 아니면 도 1의 평면 밖으로 회전되어, 자기저항 센서(102)의 전기 저항을 변화시킨다. 자기저항 센서(102)에 의해 감지되는 비트의 값(예를 들어, 1 또는 0)은 자기저항 센서(102)에 접속된 제 1 전극에서부터 제 2 전극으로 흐르는 전류를 기초로 결정될 수 있다.

[0021] 디스크 드라이브와 같은 자기 데이터 저장 디바이스의 저장 용량을 증가시키기 위해, 데이터 디스크들 상의 자기적으로 배향된 도메인들(비트들)의 크기는 지속적으로 더 작아지고 있어서 더 높은 데이터 밀도들을 생성한다. 그에 따라, 자기저항 센서(102)가 데이터 트랙(150) 상의 인접한 비트들의 자기장들로부터 실질적으로 절연되도록, 판독 헤드(100)의 크기가 더 작아질 수 있으며, 특히 차폐-대-차폐 간격(SSS)이 감소될 수 있다. SSS를 감소시키기 위해, 자기저항 센서(102)의 구현에서 시드/AFM 층(110)과 SAF 층(112)의 크로스-트랙 폭은 자유층(116)의 크로스-트랙 폭보다 더 크다. 대안적인 구현에서, AFM 층(110)과 SAF 층(112)을 포함하는 시드층 구조의 크로스-트랙 폭은 자유층(116)의 크로스-트랙 폭보다 더 크다. 도 1에 예시된 자기저항 센서(102)의 경우, AFM 층(110)과 SAF 층의 크로스-트랙 폭은 실질적으로 유사하다. 더욱이, AFM 층(110)과 SAF 층의 크로스-트랙 폭은 자유층(116)과 영구 자석들(120)의 결합된 크로스-트랙 폭과 실질적으로 유사하다.

[0022] 도 1에 예시된 구현은 전체 AFM 층(110)의 크로스-트랙 폭이 자유층(116)의 크로스-트랙 폭보다 실질적으로 더 큰 것으로 예시하지만, 대안적인 구현에서, AFM 층(110)의 부분이 자유층(116)의 크로스-트랙 폭보다 더 큰 크로스-트랙 폭을 갖는다. 예를 들면, 그러한 구현에서, AFM 층(110)은, 자유층(116)의 크로스-트랙 폭과 실질적으로 유사한 크로스-트랙 폭을 갖는 AFM 층(110)의 적어도 일부를 이용하여 드레이드된다(graded)(도시되지 않음). 예를 들면, 일 구현에서, SAF 층(112)에 근접한 AFM 층(110)의 크로스-트랙 폭보다 더 크고, 그 역도 가능하다. 마찬가지로, 대안적인 구현에서, SAF 층(112)의 부분은 자유층(116)의 크로스-트랙 폭보다 더 큰 크로스-트랙 폭을 갖는다. 예를 들면, 그러한 구현에서, SAF 층(112)은, 자유층(116)의 크로스-트랙 폭과 실질적으로 유사한 크로스-트랙 폭을 갖는 SAF 층(112)의 적어도 일부에 따라 그레이드될 수 있다(도시되지 않음). 자기저항 센서(102)의 또 다른 대안적인 구현에서, 시드층 구조(AFM 층(110) 및 SAF 층(112)의 결합)의 높이는 시드층 구조의 크로스-트랙 폭보다 더 크다. 예시된 구현에서, 시드층 구조의 높이는 도 1의 표면 안으로의 깊이로 표현된다.

[0023] 도 2는 자기저항 센서(202)를 포함하는 예시적인 판독 헤드(200)를 예시한 대안적인 개략적인 블록도를 예시한다. 예시된 구현에서, 판독 헤드(200)의 많은 양상들은 판독 헤드(100)의 대응하는 양상들과 실질적으로 유사하다. 예를 들면, 판독 헤드(200)는 제 1 차폐층(204) 및 제 2 차폐층(206)을 포함한다. 자기저항 센서(202)는 제 1 차폐층(204) 및 제 2 차폐층(206) 사이에 위치된다. 자기저항 센서(202)는 반강자성(AFM) 시드층(210), 합성형 반강자성(SAF) 층(212), 터널 배리어층(214), 자유층(216) 및 캡핑층(218)을 포함하는 복수의 층들을 포함한다. 일 구현에서, AFM 층(210)은 제 1 전극에 전기적으로 연결되고, 캡층(218)은 제 2 전극에 전기-

적으로 연결된다. 자기저항 센서(202)의 일 구현에서, 자유층(216)은 또한 한 쌍의 영구 자석들(220) 사이에 위치된 제 2 캡층을 포함한다.

[0024] 일 구현에서, SAF 층(212)은 핀드층 및 기준층을 포함한다. 핀드층 및 기준층 각각의 자기 모멘트들은 관심의 영역 내의 자기장들 하에서 회전하도록 허용하지 않는다(예를 들어, 자기장들은 데이터 디스크들 상에 저장된 데이터의 비트들에 의해 생성됨). 기준층 및 핀드층의 자기 모멘트들은 일반적으로 도 2의 평면에 수직으로 그리고 서로 역-평행하게 배향된다.

[0025] 일 구현에서, 자유층(216)은 반장자성체에 교환 결합(exchange couple)되지 않는다. 그 결과, 자유층(216)의 자기 모멘트는 관심의 영역내의 인가된 자기장의 영향 하에서 자유롭게 회전한다. 판독 헤드(200)는 도면의 평면과 평행하고 일반적으로 수평으로 배향되는 자기 모멘트로 자유층(216)을 바이어싱시키는 자기장을 생성하는 영구 자석들(PM)의 쌍(220)을 추가로 포함한다. 이러한 바이어스는 예를 들어, 판독 헤드(200)에 의해 감지되는 데이터 내로 노이즈를 도입시킬 수 있는 열 에너지로 인해 자유층(216)의 자기 모멘트가 드리프트하는 것을 방지한다. 그러나 이 바이어스는 자유층(216)의 자기 모멘트가 데이터 디스크들 상에 저장된 데이터 비트의 자기장과 같은 인가된 자기장에 응답하여 변할 수 있도록 충분히 작다. 자기저항 센서(202)는 절연 물질들을 포함하는 아이솔레이션층(222)에 의해 영구 자석들(220)로부터 분리되고 전기적으로 아이솔레이트된다.

[0026] 터널링 배리어층(214)은 SAF(212)와 자유층(216)을 분리한다. 터널링 배리어층(214)은 양자역학적 전자 터널링이 자유층(216)과 SAF(212)의 기준층 사이에서 일어나도록 충분히 얇다. 전자 터널링은 전자-스핀 의존적이어서, 자기저항 센서(202)의 자기 응답이 SAF(212)와 자유층(216)의 상대적 배향들 및 스핀 분극들의 함수가 되게 한다. SAF(212)와 자유층(216)의 자성 모멘트들이 평행일 때 가장 높은 확률의 전자 터널링이 발생하고, SAF(212)와 자유층(216)의 자성 모멘트들이 역-평행일 때 가장 낮은 확률의 전자 터널링이 발생한다. 이에 따라, 자기 저항 센서(202)의 전기 저항은 인가되는 자기장에 응답하여 변한다. 디스크 드라이브의 데이터 디스크들 상의 데이터 비트들은 도면의 평면 안으로든 아니면 도면의 평면 바깥으로든, 도 2의 평면에 수직인 방향으로 자화된다. 따라서, 자기저항 센서(202)가 데이터 비트 위를 통과할 때, 자유층(216)의 자기 모멘트는 도 2의 평면 안으로 아니면 도 2의 평면 밖으로 회전되어, 자기저항 센서(202)의 전기 저항을 변화시킨다. 자기저항 센서(202)에 의해 감지되는 비트의 값(예를 들어, 1 또는 0)은 자기저항 센서(202)에 접속된 제 1 전극에서부터 제 2 전극으로 흐르는 전류를 기초로 결정될 수 있다.

[0027] 디스크 드라이브와 같은 자기 데이터 저장 디바이스의 저장 용량을 증가시키기 위해, 데이터 디스크들 상의 자기 배향 도메인들(magnetically oriented domains)(비트들)의 크기가 지속적으로 더 작아져, 더 높은 데이터 밀도들이 생성된다. 그에 따라, 자기저항 센서(202)가 데이터 트랙 상의 인접 비트들의 자기장으로부터 사실상 아이솔레이트되도록, 판독 헤드(200)의 크기가 더 작아질 수 있고, 특히, 차폐-대-차폐 간격(SSS)이 감소될 수 있다.

[0028] 잡음을 감소시킴으로써 SNR을 개선시키기 위해, 자기저항 센서(202)의 구현에서, 시드/AFM 층(210) 및 SAF 층(212)의 크로스-트랙 폭은 자유층(216)의 크로스-트랙 폭보다 더 크다. 구체적으로, SAF/AFM 구조의 증가된 폭은 자기저항 센서(202)의 안정성을 개선시키고, 따라서 잡음의 감소를 발생시킨다. 대안적인 구현에서, 시드층 구조 – AFM 층(210) 및 SAF 층(212)을 포함함 – 의 크로스-트랙 폭은 자유층(216)의 크로스-트랙 폭보다 더 크다. 도 2에 도시된 자기저항 센서(202)의 경우, SAF 층(212)의 크로스-트랙 폭은, 자유층(216) 및 영구 자석들(220)의 결합된 크로스-트랙 폭과 실질적으로 유사하다. 대안적인 구현에서, 훨씬 더 폭넓은 SAF/AFM 구조를 갖는 것에 부가하여, FL이 위치되는 AFM 영역이 또한 제거되거나 또는 그레이드(grade)되고, 이는 SSS를 감소시킨다. 따라서, 폭넓은 SAF/AFM 구조 및 FL이 위치되는 AFM의 제거된 부분을 갖는 결합 구조는 SSS를 감소시키고 그리고 안정성의 개선 및 잡음의 감소를 발생시킨다.

[0029] 판독 헤드(200)의 AFM 층(210)은, AFM 층(210)의 크로스-트랙 표면이 영구 자석들(220)의 크로스-트랙 표면으로 사실상 제한되도록 구성된다. 예컨대, 도 2에 도시된 바와 같이, AFM 층(210)의 내부 에지는 영구 자석들(220)의 내부 에지와 사실상 정렬된다. AFM 층(210)의 그러한 구조는, 더 낮은 차폐-대-차폐 간격(SSS)을 가진 자기저항 센서(202)가 구성되도록 허용한다.

[0030] 도 2에 도시된 구현은 전체 AFM 층(210)의 크로스-트랙 폭이 자유층(216)의 크로스-트랙 폭보다 실질적으로 더 큰 것으로 도시하지만, 대안적인 구현에서, AFM 층(210)의 일부는, 자유층(216)의 크로스-트랙 폭보다 더 큰 크로스-트랙 폭을 갖는다. 예를 들어, 그러한 구현에서, AFM 층(210)은, 자유층(216)의 크로스-트랙 폭과 실질적으로 유사한 크로스-트랙 폭을 갖는 AFM 층(210)의 적어도 일부를 이용하여 그레이드된다(도시되지 않음). 유사하게, 대안적인 구현에서, SAF 층(212)의 일부는, 자유층(216)의 크로스-트랙 폭보다 더 큰 크로스-트랙 폭을

갖는다. 예를 들어, 그러한 구현에서, SAF 층(212)은, 자유층(216)의 크로스-트랙 폭과 실질적으로 유사한 크로스-트랙 폭을 갖는 SAF 층(212)의 적어도 일부에 따라 그레이드된다(도시되지 않음). 자기저항 센서(202)의 또 다른 대안적인 구현에서, (AFM 층(210)과 SAF 층(212)이 결합된) 시드층 구조의 높이는 시드층 구조의 크로스-트랙 폭보다 더 크다. 도시된 구현에서, 시드층 구조의 높이는 도 2의 표면 안으로의 깊이에 의해 표현된다.

[0031] 판독 헤드(200)의 대안적인 일 구현에서, 자기저항 센서(202)에 더 근접한 제 1 차폐(204)의 섹션은 자기저항 센서(202)의 폭과 동일한 폭을 갖는다. 그러나, 대안적인 구현들에서, 자기저항 센서(202)에 더 근접한 제 1 차폐(204)의 섹션의 폭은, 자기저항 센서(202)의 폭보다 더 작거나 또는 더 큰 폭을 갖는다. 자기저항 센서(202)에 더 가까운 제 1 차폐(204)의 섹션의 폭과 자기저항 센서(202)의 폭의 비는 SAF의 안정성 및 유효한 SSS에 영향을 준다. 즉, 이 비는 설계자로 하여금, SAF의 안정성과 SSS에서의 유효한 감소 사이에서 트레이드 오프하게 한다. 자기저항 센서(202)에 더 가까운 제 1 차폐(204)의 섹션의 폭이 더 작아짐에 따라, SAF 안정성이 더 높아지고 유효한 SSS가 더 높아지며, 그 역도 가능하다.

[0032] 자기저항 센서들(102 및 202)의 구현은, AFM 패터닝의 프로세스에서 AFM 입자들을 절단하고 그에 따라 여분의 작은 AFM 입자들을 생성하는 것과 관련된 문제들을 제거한다. 이를 감소된-사이즈의 입자들은 더 작고, 종종 불안정하다. 자기저항 센서들(102 및 202)의 제안된 구현에 대한 AFM 입자들은, 감소된-사이즈 AFM 입자 불안정성이 자기저항 센서들(102 및 202)에 영향을 주지 않도록 자유층들로부터 멀리 떨어져 절단된다. 더욱이, 더 얇은 영구 자석들(120 및 220)일 수록 더 적은 SAF 바이어스를 생성하며, 따라서, SAF 상에서의 영구 자석 토크를 감소시키고 그에 따라 이것을 더 안정하게 하기 위해서 SAF를 밸런싱한다. 자기저항 센서(202)의 구현은 부가적으로, 자유층(216)에서의 차폐-대-차폐 간격(SSS)을 추가적으로 감소시키고, 따라서, 0.3*AFM 만큼 PW50을 개선시킨다.

[0033] 도 3 내지 도 9는 자기저항 센서를 포함하는 예시적인 판독 헤드를 제조하는 다양한 스테이지들을 도시한다. 자기저항 센서를 형성하기 위한 방법의 일 구현은, 이전에 증착된 물질의 제거를 위한 이온-밀링(ion-milling) 및 마스킹층들과 같은 기술들을 포함한다. 부가적으로, SAF 층들이 영향을 받지 않는 것을 보장하기 위해, 판독기의 폭의 형성 동안에, SAF/AFM 층들을 제거하지 않고, 자유층을 제거하기 위해, 종료점 검출 기술들이 사용된다. 자기저항 센서의 대안적인 구현에서, PM의 두께는, 인접된 접합 센서 설계들의 다른 구현들에 비하여 감소된다. PM의 그러한 구현은, 자유층(Fl)을 안정화하기 위해 이용가능한 폴러스의 양을 감소시킨다. 더욱이, 대안적인 구현에서, PM과 FL 사이의 아이솔레이션층의 두께가 또한 실질적으로 감소된다.

[0034] 구체적으로, 도 3은, 시드/AFM 층(310), SF 층(312), 터널링 배리어층(314), 및 자유층(322)을 포함하는 자기저항 센서 스택(300)의 층들의 에어 베어링 표면(ABS) 뷔를 도시한다. 자기저항 센서 스택(300)은, 본원에서 개시된 자기저항 센서를 제조하기 위한 시작 구성으로서 사용된다.

[0035] 도 4는, 마스크(430)가 자유층(422) 상에 제공되는 마스킹 동작(400)을 도시한다. 부분적으로 형성된 자기저항 센서(402)는, 시드층(410), SAF 층(412), 배리어층(414), 및 자유층(422)을 포함한다. 도 4에서 도시된 바와 같이, 마스크(430)는 자유층(422)의 제한된 및 중앙의 부분 상에 증착된다. 일 구현에서, 마스킹 층(430)의 폭은 자기 저항 센서의 판독기 폭을 정의한다. 일 대안적인 구현에서, 마스크(430)는, 이미지 전사층, 및 그 이미지 전사층 위에 증착된 포토레지스트의 층(미도시)을 포함한다. 이미지 전사층은 가용성 폴리머 또는 몇몇 다른 유사한 적합한 물질일 수 있다. 하나 또는 그 초과의 하드 마스크 층들, 저부 반사방지 코팅, 및/또는 릴리즈(release)층과 같은(그러나, 이들로 제한되지 않는다) 다른 마스킹 층들이 또한 마스크(430)에 제공될 수 있다.

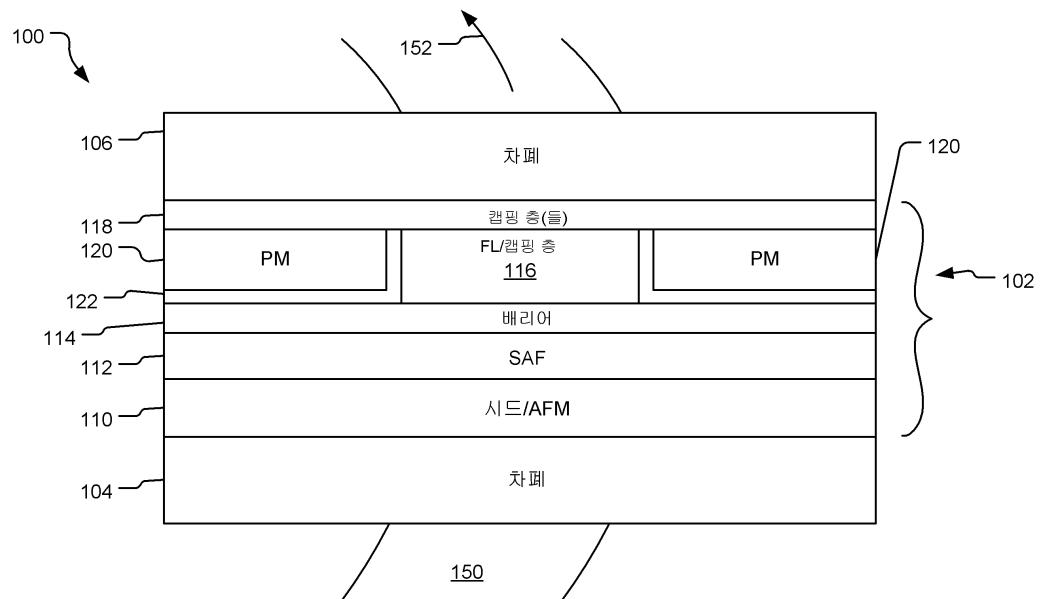
[0036] 도 5는 자기저항 센서를 제조하기 위한 후속 동작(500)을 도시한다. 구체적으로, 도 5에서 도시된 바와 같이, 자유층(522)은 추가로, 이온 밀링 및/또는 반응성 에칭 동작(502)에 의해 정의된다. 자유층(522)의 에칭은, 마스크 층(530)에 의해 커버되지 않은 자유층(522)의 부분에 대하여 터널링 배리어층(514)의 적어도 일 부분을 노출시킨다. 일 구현에서, 이온/밀링 및/또는 반응성 에칭 동작(502)은 SAF 층(512) 및 AFM 층(510)에 영향을 미치지 않는다. 대안적인 구현에서, 이온 밀링 및/또는 반응성 에칭 동작(502)은 또한, 마스크 층(530)에 의해 자유층(522)이 커버되지 않은 구역들에서 배리어층(514) 및 SAF 층(512)을 제거한다.

[0037] 도 1에 도시된 자기저항 센서(102)와 실질적으로 유사한, 도 6에 도시된 바와 같은 자기저항 센서(602)를 발생시키기 위해, 동작(500) 이후에 결과적으로 발생된 자기저항 센서는, PM을 증착하는 것, 마스크(530)를 제거하는 것 등을 비롯한 일련의 동작들을 이용하여 추가로 프로세싱된다. 추가적으로, 자기 판독기(600)를 제조하기 위해 하부 차폐(604) 및 상부 차폐(606)가 추가된다.

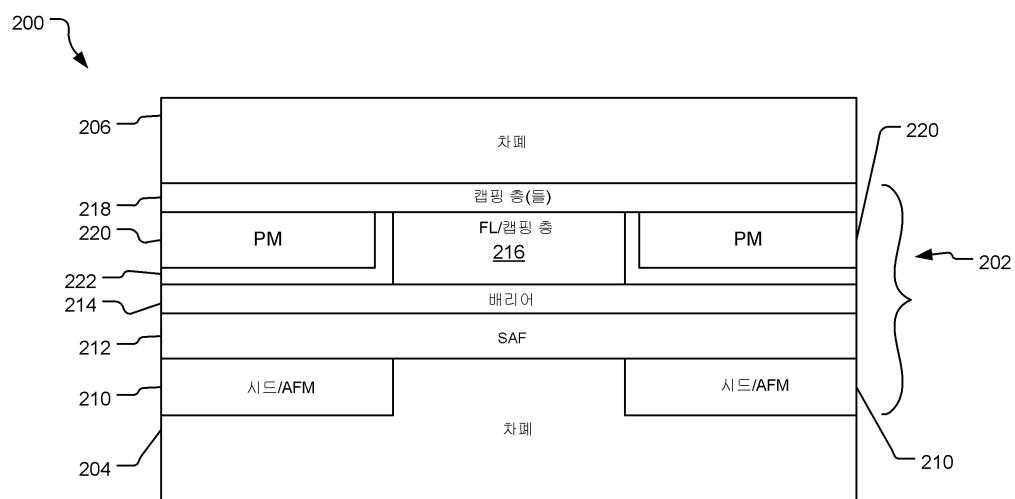
- [0038] 도 7은 자기저항 센서(702)를 포함하는 예시적인 판독 헤드(700)를 도시하는 대안적인 개략적 블록도를 예시한다. 구체적으로, 자기저항 센서(702)는 배리어층(714) 위에 위치되는 측부 차폐(710) 및 측부 차폐(712)를 포함한다. 일 구현에서, 측부 차폐들(710 및 712)은 강자성 물질로 이루어진다. 추가적으로, 판독 헤드(700)를 제조하기 위해 하부 차폐(704) 및 상부 차폐(706)가 추가된다.
- [0039] 도 8은 자기저항 센서(802)를 포함하는 예시적인 판독 헤드(800)를 도시하는 대안적인 개략적 블록도를 예시한다. 구체적으로, 자기저항 센서(802)는 배리어층(814) 위에 위치되는 측부 차폐(810) 및 측부 차폐(812)를 포함한다. 추가적으로, 판독 헤드(800)를 제조하기 위해 하부 차폐(804) 및 상부 차폐(806)가 추가된다. 일 구현에서, 측부 차폐들(810 및 812)은 강자성 물질로 제조되며, 상부 차폐(806)에 인접한다.
- [0040] 도 9는 자기저항 센서(902)를 포함하는 예시적인 판독 헤드(900)를 도시하는 대안적인 개략적 블록도를 예시한다. 추가적으로, 판독 헤드(900)를 제조하기 위해 하부 차폐(904) 및 상부 차폐(906)가 추가된다. 자기저항 센서(902)는 제 1 시드/AFM 층(910) 및 제 2 시드/AFM 층(912)을 포함하며, 차폐층(904)의 적어도 일부가 자유층(916)의 크로스-트랙 폭과 실질적으로 유사한 크로스-트랙 폭을 갖도록, 시드/AFM 층들(910 및 912)이 그레이드된다(graded). 따라서, 시드/AFM 층들(910 및 912)은 자유층(916)과 중첩되지 않는다. 이러한 구조는, AFM 패터닝의 프로세스에서 AFM 층 입자들을 절단하고 이것이 여분의 작은 AFM 입자들을 생성하는 문제점을 제거할 수 있다. 감소된 크기의 입자들은 작으며, 종종 불안정하다. 본 명세서에 개시된 구조는, AFM 입자들이 자유층으로부터 멀리 떨어져서 절단되게 하고 감소된-크기의 AFM 입자들과 연관된 불안정성을 감소시키게 한다.
- [0041] 도 10은 자기저항 센서(1002)를 포함하는 예시적인 판독 헤드(1000)를 예시하는 대안적인 개략적 블록도를 도시한다. 추가적으로, 판독 헤드(1000)를 제조하기 위해 하부 차폐(1004) 및 상부 차폐(1006)가 추가된다. 자기저항 센서(1002)는 시드/AFM 층(1010)을 갖고, 여기서 시드/AFM 층(1010)은 자유층(1016)에 가까운 층이 더 넓은 사다리꼴 형상을 갖는다. 구체적으로, 시드/AFM 층(1010)은, 시드/AFM 층(1010)의 적어도 일부가 자유층(1016)의 크로스-트랙 폭과 실질적으로 유사한 크로스-트랙 폭을 갖도록 그레이드된다.
- [0042] 도 11은 자기저항 센서를 포함하는 판독 헤드에 의해 달성될 수 있는 비대칭 감소를 예시하는 그래프를 도시한다. 구체적으로, 도 11은 판독 헤드들의 횡방향 트랜스퍼 커브들의 그래프를 도시한다. 실선 커브(1110)는 자유층의 크로스-트랙 폭과 실질적으로 유사한 크로스-트랙 폭을 갖는 SAF 층을 구비한 자기저항 센서에 대한 횡방향 트랜스퍼 커브를 그린다. 반면에, 점선 커브(1112)는 자유층의 크로스-트랙 폭보다 실질적으로 더 큰 크로스-트랙 폭을 갖는 SAF 층을 구비한 자기저항 센서에 대한 횡방향 트랜스퍼 커브를 그린다. 도시된 바와 같이, 더 넓은 SAF를 갖는 자기저항 센서의 경우 비대칭도에 있어서 상당한 감소가 있다. 구체적으로, 실선 커브(1110)는 40nm의 SAF 크로스-트랙 폭 및 8nm의 PM 크로스-트랙 폭을 가지며, 결과적으로 대략 14%의 비대칭도를 발생시키는 스택에 대한 트랜스퍼 커브를 도시한다. 이와 비교하여, 점선 커브(1112)는 200nm의 SAF 크로스-트랙 폭 및 8nm의 PM 크로스-트랙 폭을 가지며, 결과적으로 대략 4%의 비대칭도를 발생시키는 스택에 대한 트랜스퍼 커브를 도시한다.
- [0043] 상술한 상세한 설명, 실시예들, 및 데이터는 본 발명의 예시적인 구현들의 구조 및 용도의 완전한 설명을 제공한다. 본 발명의 수많은 구현들이 본 발명의 사상 및 범위로부터 벗어나지 않고 이행될 수 있기 때문에, 본 발명은 첨부된 이하의 청구항들에 존재한다. 더욱이, 상이한 구현들의 구조적 특징들은 인용된 청구항들로부터 벗어나지 않고 또 다른 구현에 조합될 수 있다. 위에서 설명된 구현들 및 다른 구현들은 이하의 청구항들의 범위 내에 있다.

도면

도면1



도면2



도면3

300



도면4

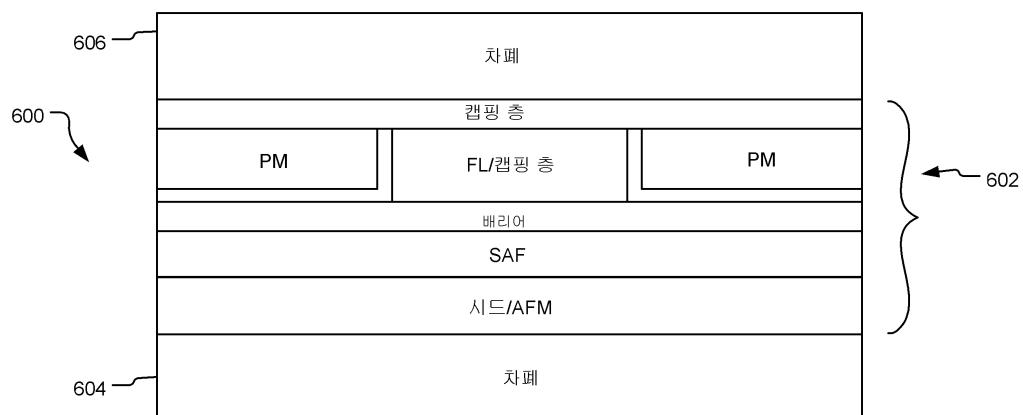
400



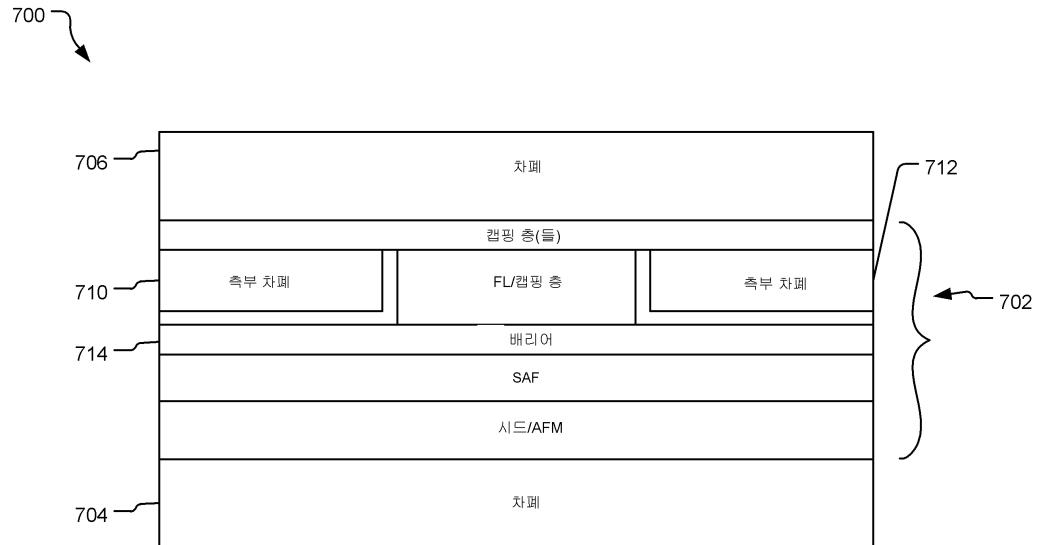
도면5



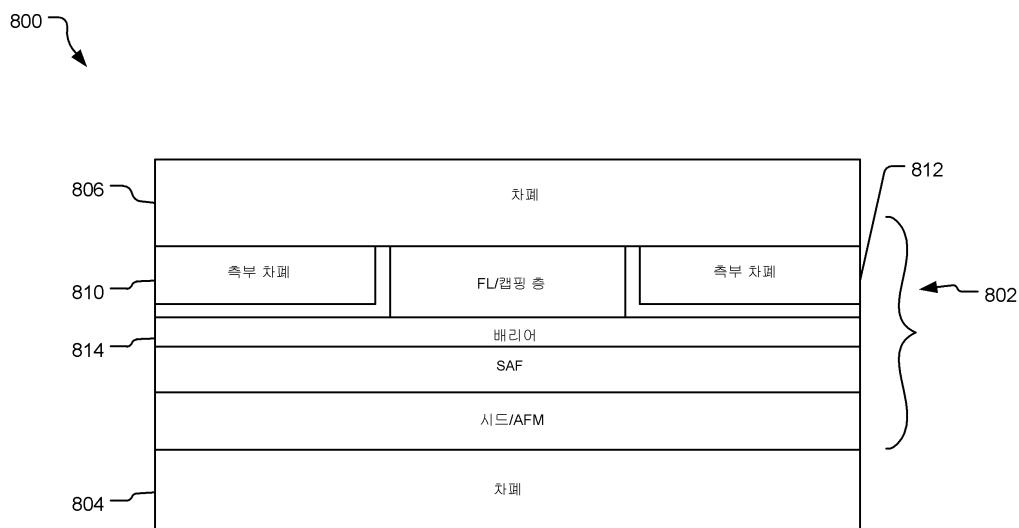
도면6



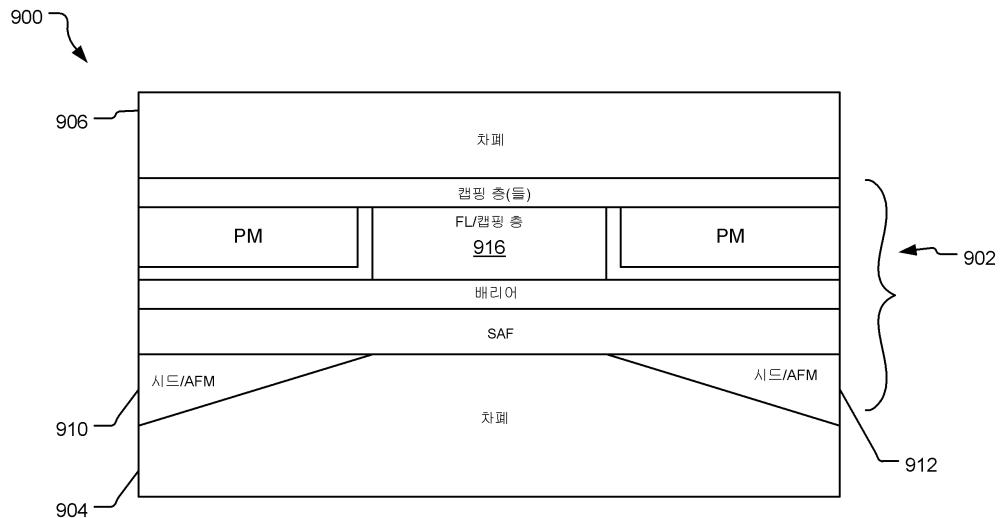
도면7



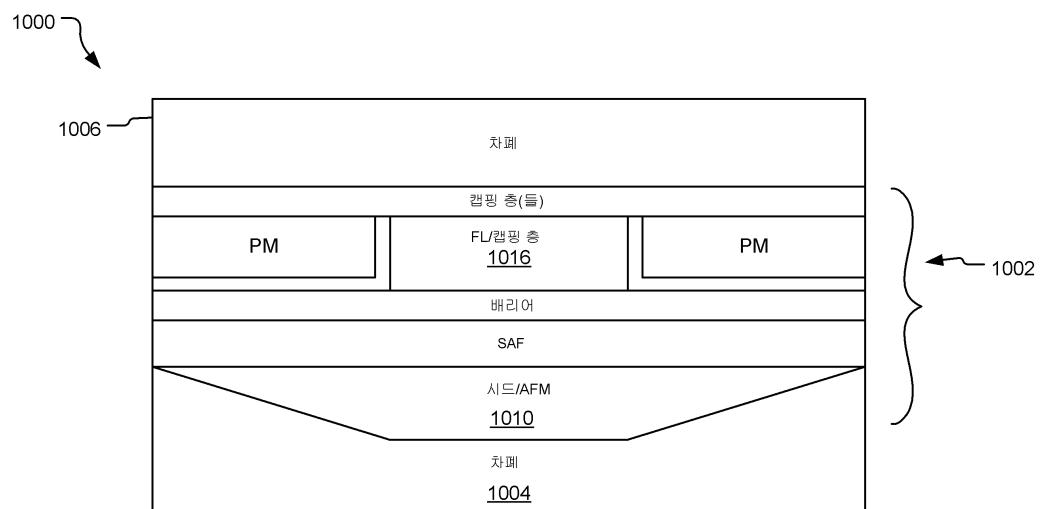
도면8



도면9



도면10



도면11

